#### (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# . 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 | 18

# (43) 国際公開日 2004 年9 月10 日 (10.09.2004)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2004/077822 A1

(51) 国際特許分類7:

H04N 5/335

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/002282

(22) 国際出願日:

2004年2月26日(26.02.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2003-054589

2003年2月28日 (28.02.2003) JP

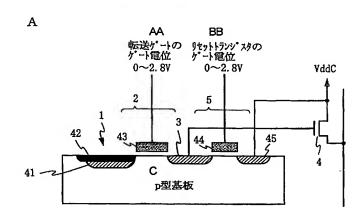
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真1006 Osaka (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 稲垣 誠 (INAGAKI, Makoto). 松長 誠之 (MATSUNAGA, Yoshiyuki).
- (74) 代理人: 小笠原 史朗 (OGASAWARA, Shiro); 〒5640053 大阪府吹田市江の木町3番11号第3ロンデェビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

[続葉有]

#### (54) Title: SOLID-STATE IMAGING DEVICE DRIVING METHOD

#### (54) 発明の名称: 固体撮像装置の駆動方法



B

D
電位(V)

RSchL
VddC-L

2.8V:VddC-H

AA...GATE POTENTIAL OF TRANSFER GATE BB...GATE POTENTIAL OF RESET TRANSISTOR C...p-TYPE SUBSTRATE

D...POTENTIAL (V)

(57) Abstract: A photosensitive cell includes a photodiode (1), a transfer gate (2), a floating-gate diffusion layer (3), an amplifying transistor (4), and a reset transistor (5). The drain of the amplifying transistor (4) is connected to a power supply line (10), to which a pulse power supply voltage (VddC) is applied. The low-level potential (VddC\_L) of the power supply voltage is a predetermined one higher than the zero potential. Specifically, the low-level potential (VddC\_L) is made higher than the channel potential of the reset transistor (5) of when the low-level potential is applied, the channel potential of the transfer gate (2) of when the low-level potential is applied, and the channel potential of the photodiode (1), and therefore a reproduction image with less noise can be read.

ル電位や、転送ゲート(2)のローレベル印加時のチャネル電位や、フォトダイオード(1)のチャネル電位より 高くすれば、雑音の少ない再生画像を読み出すことができる。



NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU,

MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。



#### 明細書

## 固体撮像装置の駆動方法

#### 技術分野

本発明は、家庭用ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、携帯電話用カメラなど、各種の機器に用いられるMOS型固体撮像装置の駆動方法に関する。

#### 背景技術

図5および図6を参照して、従来のセンサ、およびその駆動方法を説明する。図5は、従来のセンサの回路図である。図5に示すセンサは、2×2のマトリックス状に配列された感光セル(破線で囲んだ部分)を備えている。各口ーティング拡散層部53、増幅トランジスタ54、リセクトランジスタ55、およびアドレストランジスタ56を含み、画像を構成する1つの画素に対応する。なお、では、説明を簡単にするために、感光セルは2×2の下では、説明を簡単にするために、感光セルは2×2の下でリックス状に配列されていると仮定するが、実際には死のウス状に配列されていると仮定するが、実際には列される。

図 5 に示すセンサの駆動方法は、以下のとおりである。 1 行目の感光セルから信号を取り出すためには、まず、1 行目の感光セルに含まれるアドレストランジスタ 5 6 a、 5 6 b が、垂直シフトレジスタ 6 1 から O N 状態に制御さ



れる。次に、リセットトランジスタ55a、55bが、同 様に、垂直シフトレジスタ61から〇N状態に制御される 。これにより、フローティング拡散層部53a、53bは リセットされる。このとき、増幅トランジスタ 5 4 a と負 荷トランジスタ 6 3 p とによってソースホロア回路が構成 され、垂直信号線62p上にはこのソースホロア回路の出 力が現れる。同様に、増幅トランジスタ54bと負荷トラ ンジスタ63gとによってソースホロア回路が構成され、 垂直信号線62 q上にもソースホロア回路の出力が現れる 。このとき垂直信号線62p、62Q上に現れる電圧は、 フォトダイオード51 a、51 b に蓄積された信号電荷と は無関係な雑音電圧である。次に、転送ゲート52a、5 2 bが、垂直シフトレジスタ61から〇N状態に制御され る。これにより、フォトダイオード51a、51bに蓄積 された信号電荷がフローティング拡散層部53 a、53 b に転送され、垂直信号線62p、62q上には、フォトダ イオード51 a、51 bに蓄積されていた信号電荷に対応 する信号電圧が現れる。

クランプ容量 6 4 p、 6 4 q、 クランプトランジスタ 6 5 p、 6 5 q、 サンプルホールドトランジスタ 6 6 p、 6 6 q、 およびサンプルホールド容量 6 7 p、 6 7 q は、 雑音抑圧回路を構成する。この雑音抑圧回路は、フローティング拡散層部 5 3 に信号電荷があるときの画素出力(すなわち、信号出力)と、信号電荷がないときの画素出力(すなわち、雑音出力)との差を求める。図 5 に示すセンサでは、主として、増幅トランジスタ 5 4 の閾値電圧のばらつ



きによる雑音と、リセットトランジスタ 5 5 の熱雑音である k T C 雑音とが発生する。垂直信号線 6 2 p、 6 2 q上に雑音出力が現れているときに、クランプトランジスタ 6 5 p、 6 5 q とサンプルホールドトランジスタ 6 6 p、 6 6 q とは、制御端子 7 4 、 7 5 から O N 状態に制御され、サンプルホールド容量 6 7 p、 6 7 qにはクランプ電圧が印加される。所定の時間が経過した後、クランプトランジスタ 6 5 p、 6 5 q は、制御端子 7 4 から O F F 状態に制御される。

次に、垂直信号線62p、62gには、雑音のない信号 電圧と雑音電圧の和に等しい電圧が現れる。垂直信号線6 2 p、62 q は雑音電圧から信号電圧と雑音電圧との和に 変 化 し 、 そ の 変 化 分 は 雑 音 の な い 信 号 電 圧 に 相 当 す る 。 し たがって、クランプ容量64p、640のサンプルホール ド側電圧も、雑音のない信号電圧に相当する分だけ変化す る。実際に、サンプルホールド容量67p、67gにかか る 電 圧 は 、 雑 音 の な い ク ラ ン プ 電 圧 か ら 、 垂 直 信 号 線 6 2 p 、 6 2 q の 信 号 電 圧 変 化 分 を ク ラ ン プ 容 量 と サ ン プ ル ホ ールド容量で分圧した電圧分だけ変化する。よって、サン プルホールド容量67p、67gにかかる電圧は、雑音の ないクランプ電圧と分圧された信号電圧とであり、雑音分 が除去されている。サンプルホールドトランジスタ66p 6 6 g が O F F 状態に制御された後、水平シフトレジス タ 6 9 によって、水平トランジスタ 6 8 p 、 6 8 q が 順 次 選択的にON状態に制御される。これにより、フォトダイ オード51 a、51 bに蓄積されていた信号電荷に対応す



る信号が、出力端子70から順次出力される。

次に、2行目の感光セルから信号を取り出すために、2 行目の感光セルについて、1行目の場合と同様の操作が行われる。これにより、フォトダイオード51 c、51 dに蓄積されていた信号電荷に対応する信号が、出力端子70から順次出力される。

図 5 に示すセンサでは、 4 個のトランジスタ (転送ゲート 5 2、 増幅トランジスタ 5 4、 リセットトランジスタ 5 5、 およびアドレストランジスタ 5 6 ) によって、各感光セルが構成されている。これに対して、最近、センサの小型化のために、 3 個のトランジスタで各感光セルを構成し



たセンサが考案されている。この新しく考案されたセンサは、図5に示すセンサからアドレストランジスタ56を除去した上で、感光セルの電源を共通化した構成を有している。このセンサから信号を読み出すためには、各感光セルにパルス状の電源電圧を供給する必要がある。

なお、図5に示すセンサの駆動方法は、例えば、日本国特開平9-247537号公報に記載されている。また、日本国特開平2001-45375号公報には、フォトダイオードの1行分の信号を1水平期間内で平均的に出力するための駆動方法が記載されている。

しかしながら、各感光セルを3個のトランジスタで構成したセンサには、電源をパルス駆動することに伴い、以下のような問題が発生する。第1に、電源がすべての感光セルに接続され、選択された感光セルだけでなくセンサ全体が駆動されるので、センサ全体の動作に影響が生じる。第2に、ハイレベル時の電源電圧が選択されていない。第2に、ハイレベル時の電源電圧が選択されていない。光セルの動作に影響を与える。第3に、電源をパルス駆動すること自体が、センサ全体に様々な影響を与える。

特に、上記第2の問題点について言えば、電源のローレベル電位が低くなりすぎると、このローレベル電位が、選択されていない感光セルのリセットトランジスタのローレベル電位以下になり、増幅トランジスタのゲート領域にまで達する場合がある。このとき、多数の増幅トランジスタが、一斉に動作してセンサ全体を駆動する。このため、水平プランキング期間に大きな雑音が重畳され、信号処理が



難しくなる。

また、電源のローレベル電位が選択されていない感光セルの転送ゲートのローレベル電位以下になると、電荷がフォトダイオードに注入され、各感光セルに注入される電荷の量にばらつきが生じる。このため、フォトダイオードから読み出す信号電荷にばらつきが生じ、再生画像に大きな雑音が現れる。

それ故に、本発明は、各感光セルを 3 個のトランジスタで構成したセンサから、雑音の少ない再生画像を読み出すための固体撮像装置の駆動方法を提供することを目的とする。

#### 発明の開示

本発明は、上記のような目的を達成するために、以下に述べるような特徴を有している。

本発明に係る固体撮像装置の駆動方法は、半導体基板上に、入射光を光電変換し得られた信号電荷を蓄積する電電・ダイオードと、フォトダイオードに蓄積された信号電荷を出た。を転送トラング拡散層部と、カローティング拡散層部は高温を増幅を増幅を増幅を対した。カローティンが拡散層部に蓄積された信号電がと、カウンが大力を変が、対したを変が、対したを変が、対したを変が、対したを変が、対したを変が、対したを変が、対したを変が、対したを変が、対したを変が、対したを変が、対したを変が、対したを変が、対したを変が、対したを変が、対して接続される電源ラインによびスタのドレインに共通して接続される電源ラインに対してを変が、対してを変が、対してを表がある。



たリセットトランジスタとをそれぞれ駆動する垂直ドライ バ回路と、同じ列に配列された増幅トランジスタに共通し て接続される複数の垂直信号線と、それぞれが各垂直信号 線に接続される複数の負荷トランジスタと、垂直信号線に 出力される信号の雑音を抑圧する雑音抑圧回路と、行方向 に並べて配列され、雑音抑圧回路の出力が入力される複数 の水平トランジスタと、水平トランジスタを順次選択的に 動作させることにより、雑音抑圧回路の出力を順次出力さ せる水平ドライバ回路とを備えた固体撮像装置の駆動方法 であって、各水平期間ごとに、電源ラインをパルス駆動す るステップと、垂直ドライバ回路によって、各水平期間ご とに、順次異なる行を選択し、選択した行に配列された感 光セルについて、電源ラインが駆動されている間に、リセ ットトランジスタと転送トランジスタとを相次いで動作さ せた後、電源ラインが駆動されていない間に、リセットト ランジスタを動作させるステップと、水平ドライバ回路に よって、各水平期間ごとに、雑音抑圧回路の出力を順次出 カさせるステップとを備え、電源ラインのローレベル電位 が、ゼロ電位より高い所定の電位であることを特徴とする

この固体撮像装置の駆動方法によれば、電源ラインのローレベル電位をゼロ電位より高くすることにより、センサ全体が駆動されないようにしたり、各画素における電位を安定させたりすることができる。したがって、雑音の少ない再生画像を読み出すことができる。

上記固体撮像装置の駆動方法において、上記所定の電位



は、リセットトランジスタのローレベル印加時のチャネル電位より高くてもよい。これにより、増幅トランジスタは、ゲート領域付近で動作することがなくなるので、多数の増幅トランジスタが一斉に動作してセンサ全体を駆動することがなくなる。したがって、水平ブランキング期間に大きな雑音が重畳され、信号処理が難しくなるという問題を解決することができる。

あるいは、上記所定の電位は、転送トランジスタのローレベル印加時のチャネル電位より高くてもよい。これにより、フォトダイオードに注入される電荷のために、感光セルでは注入される電荷の量にばらつきが生じることがなくなる。したがって、再生画像に大きな雑音が現れることがなく、雑音の少ない再生画像を読み出すことができる。

あるいは、上記所定の電位は、フォトダイオードのチャネル電位より高くてもよい。これにより、センサ全体が駆動されないようにしたり、各画素における電位を安定させたりすることができる。したがって、雑音の少ない再生画像を読み出すことができる。

また、上記固体撮像装置の駆動方法において、感光領域は、p型基板上に形成されていてもよい。これにより、p型基板上に形成された感光領域を備えた固体撮像装置から、雑音の少ない再生画像を読み出すことができる。

あるいは、感光領域は、n型基板上のp型ウェル内に形成されていてもよい。これにより、n型基板上のp型ウェル内に形成された感光領域を備えた固体撮像装置から、雑音の少ない再生画像を読み出すことができる。



#### 図面の簡単な説明

図1は、本発明の実施形態に係るセンサの回路図である

図2Aおよび図2Bは、本発明の実施形態に係るセンサの雑音抑圧回路の詳細を示す図である。

図3は、本発明の実施形態に係るセンサの駆動方法を示すタイミングチャートである。

図4Aおよび図4Bは、本発明の実施形態に係るセンサの感光セルの断面図および電位図である。

図5は、従来のセンサの回路図である。

図6は、従来のセンサの駆動方法を示すタイミングチャートである。

## 発明を実施するための最良の形態

図1は、本発明の実施形態に係るセンサの回路図である。図1に示すセンサは、m×nのマトリックス状に配列された感光セル(破線で囲んだ部分)、電源ライン10、垂直シフトレジスタ11、n本の垂直信号線12-1~n、n個の負荷トランジスタ、および水平シフトレジスタ16を備えている。各感光セルは、フォトダイオード1、転送ゲート2、フローティング拡散層部3、増幅トランジスタ4、およびリセットトランジスタ5)を含み、ランジスタ4、およびリセットトランジスタ5)を含み、カンジスタ4、およびリセットトランジスタ5)を含み、カンジスタ4、およびリセットトランジスタ5)を含み、カンジスタ4、およびリセットトランジスタ5)を含み、カンジスタ4、およびリセットトランジスタ5)を含み、カンジスタ4、およびリセットトランジスタ5)を含み、カンジスタ4、およびリセットトランジスタ5)を含み



アドレストランジスタを含まないことを特徴とする。 実際のセンサにおけるmおよびnの値は、数十から数千程度である。

m×n個の感光セルは、半導体基板上に形成される。より詳細には、感光セルは、p型基板上、または、n型基板上のpウェル(P-well)内に形成される。各感光セルにおいて、フォトダイオード1は、入射光を光電変換トラインが、大信号電荷を蓄積する。転送ゲート2は、フォトダイオード1に蓄積された信号電荷をフローティンが拡散層部3に転送する。フローティンが拡散層部3に転送する。ガイオード1から転送された信号電荷を一時的に蓄づる。増幅トランジスタ4は、フローティンが拡散層部3に蓄積された信号電荷を増幅する。リセットトランジスタ5は、フローティンが拡散層部3に蓄積された信号電荷を増幅する。リセットトランジスタ5は、フローティンが拡散層部3に蓄積された信号電荷を

感光セルが配列された感光領域には、電源ライン10および垂直信号線12-1~nに加えて、2組のm本の信号線17-1~m、18-1~mが配線される。電源ライン10は、増幅トランジスタ4のドレインに共通しての接続される。本実施形態では、電源ライン10は、すべての感光セルに含まれる増幅トランジスタ4およびリセットトランジスタ5のドレインに共通して接続され、電源ライン10の他端にある電源供給端子20から、すべての感光セルが1本の電源ラ



イン10に接続されているが、感光セルに共通した電源を供給するために、電源ラインを2本以上使用してもよい。

垂直信号線12−1~nは、感光セルの各列に対して設けられる。垂直信号線12~1~nは、それぞれ、同じ列に配列された感光セルに含まれる増幅トランジスタ4および負荷トランジスタ13−1~nと、雑音抑圧回路14とを接続する。信号線17−1~m、18−1~mは、垂直シフトレジスタ11の出力信号線であり、感光セルの各行に対して設けられる。信号線17−1~mは、それぞれ、同じ行に配列された感光セルに含まれる転送ゲート2のゲートを接続する。信号線18−1~mは、それぞれ、同じ行に配列された感光セルに含まれるリセットトランジスタ5のゲートを接続する。

垂直シフトレジスタ11は、以下に示すように、 ライバ回路として動作する。垂直シフトレジスタ11にに示すように、同時なスタ11にになるときに、同時にといいであるととで、同じにを動する。また、垂直シフトレジスタ11は、電源ラインときに、を同りになるときに、同じ行に配列された。また、一下のであるとがで、同じ行に配列には異なるタイミングでは、同じ行をでいる。 はよれるリセットランジスタののれたのである。 は、一下のであるとがで、同じ行をを同時に、からは異なるタイミングでに配列にはいいであるとがで、のいれたのは、 をは、カー1~nに接続されてでにが、のいたででで、 雑音抑圧回路14は、垂直信号線12~1~nに接続なれている。 雑音抑圧回路14は、垂直信号を取り込みが信号の雑音成分を除去する。水平トランジスタ1



5 - 1 ~ n は、行方向に並べて配列される。各水平トランジスタ15 - 1 ~ n には、雑音抑圧回路14から出力された n 本の信号がそれぞれ入力される。水平シフトレジスタ16は、水平ドライバ回路として動作する。すなわち、水平シフトレジスタ16は、水平トランジスタ15 - 1 ~ n を順次選択的に動作させる。これにより、雑音抑圧回路14から出力された n 本の信号は、出力端子21から順次出力される。

図2Aおよび図2Bは、雑音抑圧回路14の詳細を説明 するための図である。雑音抑圧回路14は、図2Aに示す ように、 n 個 の サンプル ホールドトランジスタ 3 1 - 1 ~ n、n個のクランプ容量32-1~n、n個のクランプト ランジスタ33-1~n、およびn個のサンプルホールド 容量 3 4 - 1 ~ n を含んでいる。雑音抑圧回路 1 4 は、図 5 に 示 し た 雑 音 抑 圧 回 路 と サ ン プ ル ホ ー ル ド ト ラ ン ジ ス タ 3 1 - 1 ~ n の 位 置 が 異 な る が 、 図 5 に 示 し た 雑 音 抑 圧 回 路とほぼ同様に動作する。サンプルホールドトランジスタ 3 1 - 1 ~ n の ゲートには、制御端子22から入力される サンプルホールド制御信号が印加される。同様に、クラン プ ト ラ ン ジ ス 夕 3 3 - 1 ~ n の ゲ ー ト に は 、 制 御 端 子 2 3 から入力されるクランプ制御信号が印加される。これら2 本の制御信号は、図2Bに示すように変化する。2本の制 御信号がともにハイレベルである期間が雑音出力期間とな り、サンプルホールド制御信号がハイレベルで、クランプ 制 御 信 号 が ロ ー レ ベ ル で あ る 期 間 が 信 号 出 力 期 間 と な る 。

以下、図3に示すタイミングチャートを適宜参照しなが



ら、図1に示すセンサの駆動方法を説明する。このセンサを駆動するためには、各水平期間ごとに、電源ライン10をパルス駆動するステップと、垂直シフトレジスタ11によって、m×n個のフォトダイオード1から1行分の信号を読み出すステップと、水平シフトレジスタ16によって、読み出した1行分の信号を順次出力するステップとが実行される。

図3に示すように、初期状態では、電源電圧VddCは ローレペルである。すなわち、初期状態では、電源ライン 1 0 は駆動されていない。1 行目の感光セルから信号を取 り出すためには、まず、電源電圧VddCがハイレベルに 制御される。これにより、すべての感光セルにおいて、転 送ゲート 2 およびリセットトランジスタ 5 のドレインがハ イレベルになる。次に、電源ライン10が駆動されている 間に、垂直シフトレジスタ11が、信号線18-1を所定 の時間だけハイレベルにする。これにより、リセットトラ ンジスタ5a、5bを始め、1行目の感光セルに含まれる リセットトランジスタ 5 のゲート 電位はハイレベルとなり 、これらリセットトランジスタ 5 は 0 N 状態となる。この とき、 増 幅 ト ラ ン ジ ス タ 4 a 、 4 b を 始 め 、 1 行 目 の 感 光 セルに含まれる増幅トランジスタ4も動作状態となる。同 時 に 、 フ ロ ー テ ィ ン グ 拡 散 層 部 3 a 、 3 b を 始 め 、 1 行 目 の感光セルに含まれるフローティング拡散層部3に蓄積さ れた信号電荷をリセットしたときの雑音出力が、垂直信号 線 1 2 - 1 ~ n に 現 れ る。

次に、電源ライン10が駆動されている間に、垂直シフ



トレジスタ11が、信号線17-1を所定の時間だけハイレベルにする。これにより、転送ゲート2a、2bを始め、1行目の感光セルに含まれる転送ゲート2のゲート電位はハイレベルとなり、これら転送ゲート2はON状態となる。このとき、フォトダイオード1a、1bを始め、1行目の感光セルに含まれるフォトダイオード1に蓄積されていた信号電荷は、各感光セルに含まれるフローティング拡散層部3に読み出され、読み出された信号電荷に対応した信号出力が、垂直信号線12-1~nに現れる。

このようにして、垂直信号線12-1~nには、雑音電圧が現れた後、信号電圧と雑音電圧との和が現れる。雑音抑圧回路14は、従来の雑音抑圧回路と同様に動作し、垂直信号線12-1~nに出力された信号の雑音を抑圧する。雑音抑圧回路14から出力されたn本の信号は、それぞれ、水平トランジスタ15-1~nに入力される。

雑音抑圧回路14が動作した後、電源電圧VddCは、ローレベルに変化する。次に、電源ライン10が駆動されていない間に、垂直シフトレジスタ11が、信号線18-1を所定の時間だけハイレベルにする。これにより、フローティング拡散層部3a、3bを始め、1行目の感光セルに含まれるフローティング拡散層部3に蓄積された信号電荷は、リセットされる。また、増幅トランジスタ4a、4bを始め、1行目の感光セルに含まれる増幅トランジスタ4は、次に選択されるまで非動作状態となる。

水平シフトレジスタ16は、水平トランジスタ15-1 ~nのゲートに接続されるn本の出力信号を出力する。水



平シフトレジスタ16は、n本の出力信号を選択的にハイレベルにすることにより、水平トランジスタ15-1~nを順次選択的にON状態に制御する。これにより、フォトダイオード1a、1bを始め、1行目のフォトダイオード1に蓄積されていた信号電荷に対応する信号が、出力端子21から順次出力される。

次に、2行目の感光セルから信号を取り出すために、2 行目の感光セルについて、1行目の場合と同様の操作が行われる。これにより、フォトダイオード1 c、1 dを始め、2行目の感光セルに蓄積されていた信号電荷に対応する信号が、出力端子21から順次出力される。以下、3行目からm行目の感光セルについても、同様の操作が行われる。なお、図3に示す水平ブランキング期間、水平有効期間、1水平期間、および1フレーム期間の定義、並びにフォトダイオード1の感度が一定になる点は、従来のセンサと同じである。

上記のようなセンサの駆動方法のうち、本実施形態では、電源電圧VddCのローレベル電位がゼロ電位より。 内定の電位であることを特徴とする駆動方法を考える。 具体的には、電源電圧VddCのローレベル電位を、リットトランジスタ 5 のローレベル印加時のチャネル電位・を、転送ゲート 2 のローレベル印加時のチャネル電位と、転送ゲート 2 のローレベル印加時のチャネル電位と、転送ゲート 2 のローレベル印加時のチャネル電位と、転送ゲート 2 のローレベル印加時のチャネル電位と、転送ゲート 3 のローレベル印加時のチャネル電位と、転送ゲート 3 のローレベル印加時のチャネル電位と、転送ゲート 3 のローレベル印加時のチャネル電位と、転送が一ト 3 の日本表表の駆動方法よりも雑音の少ない再生画像が得られる。以下、図4 A および図4 B を参照して、そ



の理由を説明する。

図4Aおよび図4Bは、それぞれ、図1に示すセンサに含まれる感光セルの断面図および電位図である。図4Aにおいて、感光セルは、p型基板上に形成されている。p型基板と、その上に形成されたp型表面層42とはまった、p型基板の表面に形成されたp型基板上にはは、ワコオトダイオード1を構成する。また、p型基板上には3とれる・ダイオード1に加えて、フローティング拡散層3を設けることによりいセットトランジスタ5が形成される。

上述したように、電源電圧VddCは、パルス状に変化する。ここでは、電源電圧VddCのハイレベル電位およびローレベル電位を、それぞれ、VdddC一HおよびVddC一Lと記す(図4Bを参照)。VddC一Hの実際の値は、例えば、2.8Vである。リセットトランジスタ5のゲートには、0Vから2.8Vの範囲で変化する電圧が印加されるが、リセットトランジスタ5のゲートにはレベル電位(0V)を印加したときのチャネル電位をTRChLと記す。これらの記法を用いれば、本実施形態では、

RSchL<VddC $_L$  … (1) および/または



TRchL< V d d C \_ L … (2)
なる関係が成り立つように、電源電圧のローレベル電位 V d d C \_ L が制御される。

上式(1)の関係が成り立つローレベル電位VddCLLを使用すれば、増幅トランジスタ4は、ゲート領域付近で動作することがなくなる。このため、多数の増幅トランジスタ4が一斉に動作して、センサ全体を駆動するという現象が生じない。したがって、水平プランキング期間に大きな雑音が重畳され、信号処理が難しくなるという問題を解決することができる。

また、上式(2)の関係が成り立つローレベル電位 V d d C L を使用すれば、フォトダイオード 1 に注入される電荷のために、感光セルでは注入される電荷の量にばらつきが生じるという現象が生じない。このため、再生画像に大きな雑音が現れることがなく、美しい再生画像を読み出すことができる。

以上に示すように、上式(1)および/または(2)の 関係が成り立つ電源電圧のローレベル電位 V d d C \_ L を 用いることにより、センサ全体が駆動されることなく、各 画素における電位が安定するので、雑音の少ない美しい再 生画像を読み出すことができる。

なお、実際には、上式(1)および(2)に代えて、あるいは、上式(1)および/または(2)に加えて、電源電圧のローレベル電位VddC\_Lとして、フォトダイオードのチャネル電位より高い電位を使用してもよい。このような電位を使用した場合も、同様に、図1に示すセンサ



から、雑音の少ない再生画像を読み出すことができる。

また、本実施形態に係る駆動方法の適用対象となるセンサは、図4Aに示したように、p型基板上に形成されたものであってもよく、n型基板内のpウェル上に形成されたものであってもよい。本実施形態に係る駆動方法は、いずれの方法で作成されたセンサにも適用できる。

## 産業上の利用可能性

以上のように、本発明に係る固体撮像装置の駆動方法は、雑音の少ない再生画像を読み出すことができるという特徴を有するので、各種の固体撮像装置から再生画像を読み出すための駆動方法として利用することができる。



#### 請求の範囲

1. 半導体基板上に、入射光を光電変換し得られた信号電荷を蓄積するフォトダイオードと、前記フォトダイオードと、前記フォトダイと、、前記フォトダイオードと、前記フォトダイと、転送トランジスタと、が記フローティング拡散層部に蓄積された信号電荷を増幅トランジスタと、前記フローティング拡散層部に蓄積された信号電荷をリセットするリセットトランジスタとを含む感光セルを行および列方向の2次元状に配列した感光領域と、

前記増幅トランジスタのドレインに共通して接続される電源ラインと、

同じ行に配列された前記転送トランジスタと同じ行に配列された前記リセットトランジスタとをそれぞれ駆動する 垂直ドライバ回路と、

同じ列に配列された前記増幅トランジスタに共通して接続される複数の垂直信号線と、

それぞれが各前記垂直信号線に接続される複数の負荷トランジスタと、

前記垂直信号線に出力される信号の雑音を抑圧する雑音抑圧回路と、

行方向に並べて配列され、前記雑音抑圧回路の出力が入力される複数の水平トランジスタと、

前記水平トランジスタを順次選択的に動作させることにより、前記雑音抑圧回路の出力を順次出力させる水平ドラ



イバ回路とを備えた固体撮像装置の駆動方法であって、

各水平期間ごとに、前記電源ラインをパルス駆動するステップと、

前記垂直ドライバ回路によって、各水平期間ごとに、順 次異なる行を選択し、選択した行に配列された感光セルに ついて、前記電源ラインが駆動されている間に、前記リセ ットトランジスタと前記転送トランジスタとを相次いで動 作させた後、前記電源ラインが駆動されていない間に、前 記リセットトランジスタを動作させるステップと、

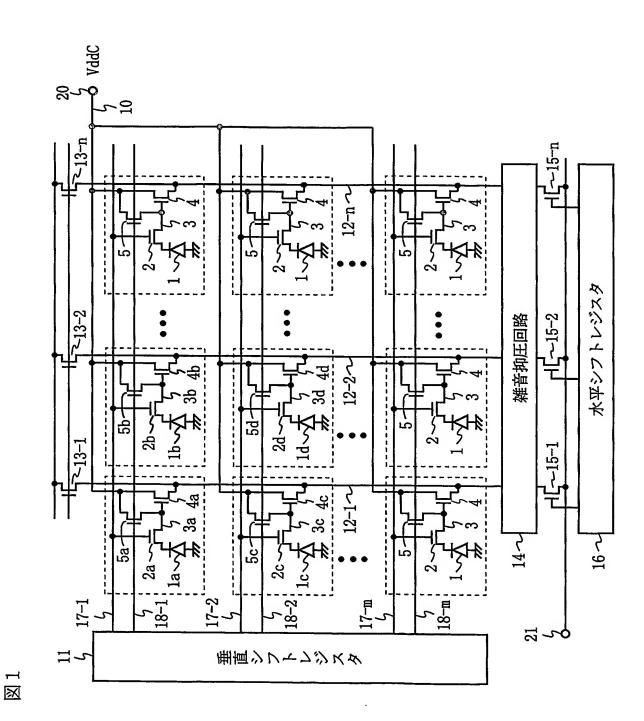
前記水平ドライバ回路によって、各水平期間ごとに、前記雑音抑圧回路の出力を順次出力させるステップとを備え

前記電源ラインのローレベル電位が、ゼロ電位より高い所定の電位であることを特徴とする、固体撮像装置の駆動方法。

- 2. 前記所定の電位が、前記リセットトランジスタのローレベル印加時のチャネル電位より高いことを特徴とする、請求項1に記載の固体撮像装置の駆動方法。
- 3. 前記所定の電位が、前記転送トランジスタのローレベル印加時のチャネル電位より高いことを特徴とする、請求項1に記載の固体撮像装置の駆動方法。
- 4. 前記所定の電位が、前記フォトダイオードのチャネル電位より高いことを特徴とする、請求項1に記載の固体撮像装置の駆動方法。
- 5. 前記感光領域が、p型基板上に形成されていることを特徴とする、請求項1に記載の固体撮像装置の駆動方法。



6. 前記感光領域が、n型基板上のp型ウェル内に形成されていることを特徴とする、請求項1に記載の固体撮像装置の駆動方法。



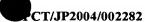
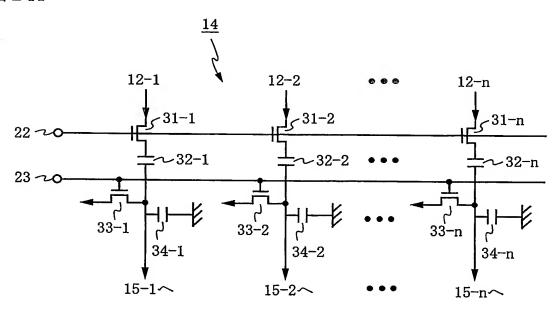
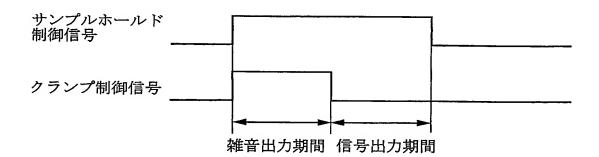
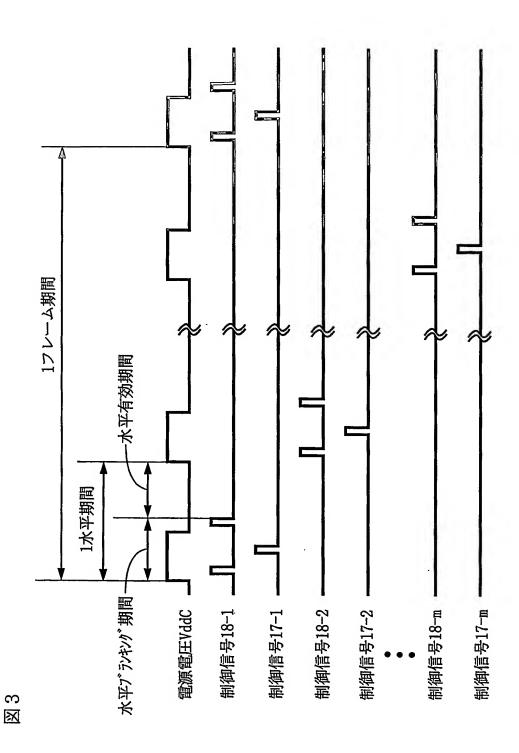


図2A



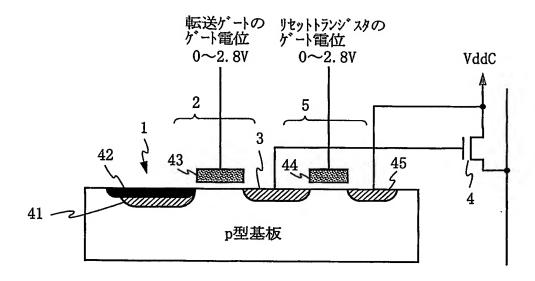
# 図2B







# 図4A



# 図4B

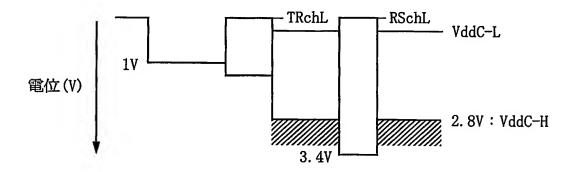
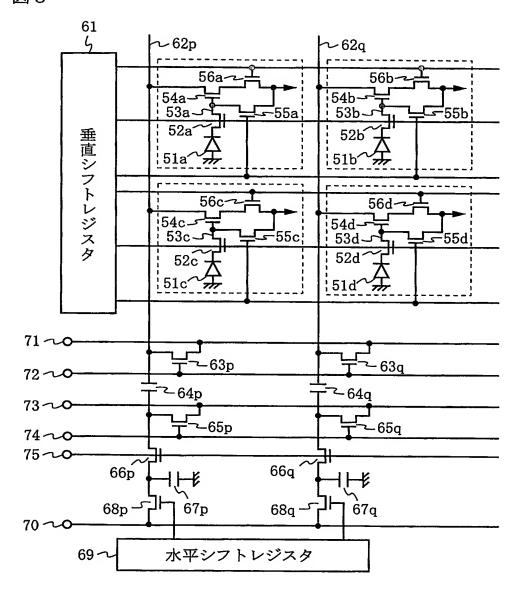
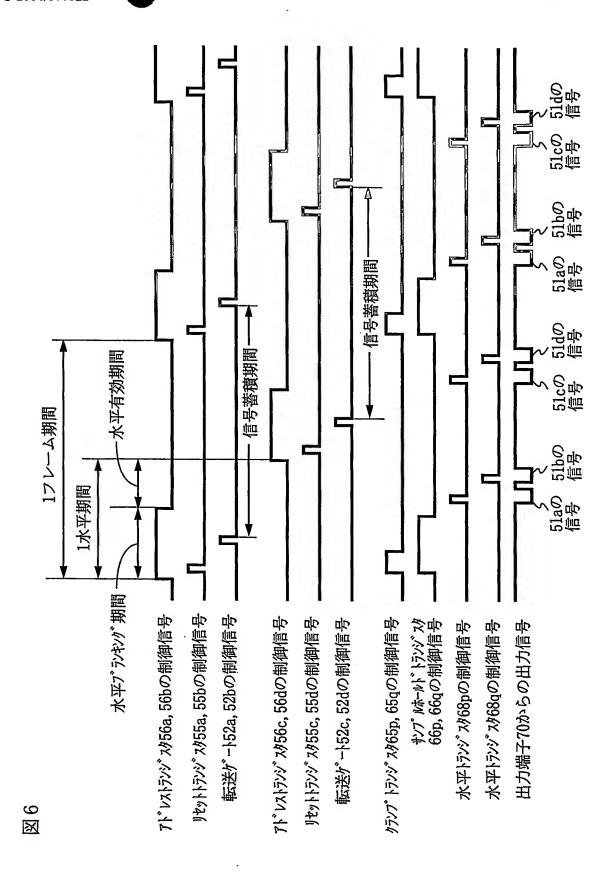




図 5







## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

		PCT/UP2	2004/002282				
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl7 H04N5/335.							
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
	B. FIELDS SEARCHED						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl <sup>7</sup> H04N5/335, H01L27/14							
Documentations	parched other than minimum documentation to the exten	at that such documents are included in th	a fields secrebed				
Jitsuyo	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004						
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of d	ata base and, where practicable, search to	erms used)				
			ŕ				
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
P,X	JP 2003-230055 A (Sony Corp.	),	1-6				
	15 August, 2003 (15.08.03), Column 8, line 12 to column 9	line 50. Figs	ł :				
ļ	5 to 11	, iiic 30, 11gs.					
	(Family: none)						
A.	JP 2002-511215 A (Sarnoff Co. 09 April, 2002 (09.04.02),	rp.),	1-6				
	Column 14, line 13 to column	21, line 9;					
	Figs. 1, 2 & WO 98/56170 A1 & EP	986900 A					
	& US 5969758 A1						
		·					
1							
		·					
× Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
"A" document defining the general state of the art which is not considered date at		"T" later document published after the int date and not in conflict with the applic the principle or theory underlying the	cation but cited to understand				
"E" earlier application or patent but published on or after the international "X" doc		"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be cons	claimed invention cannot be				
"L" document v	which may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other	step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the	е				
special reas	on (as specified) eferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	considered to involve an inventive	step when the document is				
"P" document p	ublished prior to the international filing date but later than	being obvious to a person skilled in th	e art				
the priority date claimed "&" document member of the same patent family							
Date of the actual completion of the international search  Date of mailing of the international search report							
25 May, 2004 (25.05.04) 15 June, 2004 (15.06.04)							
		Authorized officer					
Japane	se Patent Office						
Facsimile No.							
rorm PC1/ISA/2	10 (second sheet) (January 2004)						



International application No.
PCT/JP2004/002282

(Continuation	). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevan	nt passages	Relevant to claim No.
A	JP 11-112018 A (Canon Inc.), 23 April, 1999 (23.04.99), Column 4, line 38 to column 6, line 14; Fig. 1 & EP 908957 A2 & US 2003/137594 A1		
<b>A</b>	JP 10-93066 A (Toshiba Corp.), 10 April, 1998 (10.04.98), Full text; Figs. 1 to 16 (Family: none)	·	1-6
			·
	·		
	•		
	·		
		·	



	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Cl <sup>7</sup> H04N 5/335	,,				
調査を行った最	Tった分野		·			
日本国9	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの 民用新案公報 1922-1996年 公開実用新案公報 1971-2004年 登録実用新案公報 1994-2004年 民用新案登録公報 1996-2004年					
国際調査で使用	国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)					
C. 関連する 引用文献の	ると認められる文献	•	関連する			
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	さきは、その関連する箇所の表示	開東する 諸求の範囲の番号			
PΧ	JP 2003-230055 A 2003.08.15,第8欄第12 11図(ファミリーなし)		1 — 6			
A	JP 2002-511215 A ン) 2002.04.09,第12 行,第1,2図 & WO 98/5 986900 A & US 596	4欄第13行一第21欄第9 56170 A1 & EP	1-6			
X C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	 紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献						
国際調査を完了	了した日 25.05.2004	国際調査報告の発送日 15.6.2	2004			
日本国	D名称及びあて先 国特許庁(ISA/JP) 軍便番号100-8915 郡千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 徳田 賢二 電話番号 03-3581-1101	5P 9654 内線 3502			



<ol> <li>関連すると認められる文献</li> </ol>			
関連する			
	請求の範囲の番号		
JP 11-112018 A (キヤノン株式会社) 1999.04.23,第4欄第38行-第6欄第14行,第1図 & EP 908957 A2 & US 2003/1375 94 A1	1-6		
JP 10-93066 A (株式会社東芝) 1998.04.10,全文,第1-16図 (ファミリーなし)	1-6		
	& EP 908957 A2 & US 2003/1375 94 A1 JP 10-93066 A (株式会社東芝)		